

صلى الله عليه وسلم



دانشگاه تربیت مدرس  
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

# طراحی و ساخت مبدل نیروگاهی خورشیدی فتوولتائیک متصل به شبکه برق سراسری

نگارش:

مهدی جلایری

اساتید راهنما:

دکتر سید زین العابدین موسوی

دکتر پرویز امیری

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد

دورشته مهندسی برق

بهمن ماه ۱۳۹۱

# السلام عليك يا داعي الله ورباني آية

تقدیم به مولایم اباصالح المهدی (عج الله فرجه)

هر چند ران ملخی است از مورچه ای به پیشگاه سلیمان



## باسمه تعالی

### تعهدنامه اصالت اثر

اینجانب مهدی جلایری معتمد می‌شوم که مطالب مندرج در این پایان نامه حاصل کار پژوهشی اینجانب است و دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این پژوهش از آنها استفاده شده است، مطابق مقررات ارجاع و در فهرست منابع و مأخذ ذکر گردیده است. این پایان نامه/رساله قبلاً برای احراز هیچ مدرک هم سطح یا بالاتر ارایه نشده است. در صورت اثبات تخلف در هر زمان مدرک تحصیلی صادر شده توسط دانشگاه از اعتبار ساقط خواهد شد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی می‌باشد.

نام و نام خانوادگی دانشجو

امضاء

## مشکر و قدردانی

سپاس بیکران خداوند بزرگ را که مرا از تاریکی های جهل نادانی به سوی نور دانش راهنمون گشت.

از اساتید راهنمایم دکتر موسوی و دکتر امیری که بارها بنیادهای خود به موازات من کمک نمودند سپاسگزارم.

از پدر و مادرم که همواره مورد لطف خود قرار دادند مشگرم.

از همسر عزیز و دختر گرامی ام که همواره با صبوری های خود مرا تشویق نمودند کمال مشکر را دارم.

در پایان لازم می دانم از اساتید بزرگوار دکتر بطحانی و دکتر قندیاری که زحمات داورسی این پایان نامه را منتقل شدند

مشگرم بنایم.

## چکیده

در بسیاری از سیستم‌های فتوولتائیک متصل به شبکه برق، از یک مبدل DC-DC و یک اینورتر برای تزریق جریان سینوسی با سوئیچینگ فرکانس بالا استفاده می‌شود. در این پایان‌نامه از یک مبدل فلای بک که به طور مستقیم ولتاژ DC را به ولتاژ AC تبدیل می‌کند استفاده شده و آن را به صورت جریان سینوسی به شبکه تزریق می‌کند. در این پایان‌نامه از یک سیستم فتوولتائیک قدرت متصل به شبکه که ایده جدیدی در کنترل آن استفاده می‌شود می‌پردازد. در این روش کنترل از ولتاژ شبکه نمونه برداری می‌شود و به همین علت از نظر هماهنگ بودن و پایداری مشکلی وجود نخواهد داشت و به هیچ سیستم سنکرون ساز خارج از سیستم نیاز ندارد. همچنین در این پایان‌نامه به ارائه روش‌های ردیابی نقطه ماکزیمم توان (MPPT) در سیستم‌های فتوولتائیک ارائه می‌پردازد. یکی از این روش‌ها که اغتشاش و نظارت نام دارد بوسیله AVR مدل ATmega8 اجرا می‌نماید. در این تحقیق مطالعات نظری سیستم فتوولتائیک و مدل‌سازی روش‌های MPPT آن با استفاده از نرم افزار PSpice و نرم افزار MATLAB/SIMULINK شبیه‌سازی شده است. توان سیستم فتوولتائیک ۴۰ وات است. اما از آنجا که می‌توان سیستم‌های فتوولتائیک را با هم موازی کرد توان‌های بالاتر به راحتی دست یافتنی است. همچنین با اجرای این ایده در آزمایشگاه الکترونیک به ساخت این مبدل فتوولتائیک که کنترلی ساده دارد و هزینه ساخت آن کم است پرداخته شده است و درستی ایده مطرح شده در آن را به اثبات رسیده است.

## کلمات کلیدی:

اینورتر، سیستم فتوولتائیک، مدلاسیون عرض پالس، ردیاب نقطه ماکزیمم توان

## فصل اول : بیان مسئله

- ۱-۱ مقدمه ..... ۲
- ۲-۱ ضرورت توسعه سیستم های فتوولتائیک..... ۲
- ۳-۱ اهداف پایان نامه..... ۳
- ۴-۱ محتوی پایان نامه ..... ۴

## فصل دوم: مبانی نظری پدیده فتوولتائیک و اجزای سیستم مذکور

- ۱-۲ پدیده فتوولتائیک..... ۶
- ۲-۲ سلول فتوولتائیک..... ۷
- ۳-۲ مدل سازی یک سلول فتوولتائیک ..... ۹
- ۱-۳-۲ ساده ترین مدل فتوولتائیک..... ۹
- ۲-۳-۲ دقیق ترین مدل فتوولتائیک..... ۱۲
- ۴-۲ ماژول های فتوولتائیک..... ۱۳
- ۵-۲ مدل سازی یک ماژول فتوولتائیک توسط MATLAB..... ۱۴
- ۶-۲ منحنی I-V و نقطه ماکزیمم توان..... ۱۷
- ۷-۲ ویژگیهای سیستم های فتوولتائیک..... ۱۸
- ۸-۲ کاربرد سیستم های فتوولتائیک..... ۱۹
- ۹-۲ روشهای افزایش راندمان ماژول های فتوولتائیک..... ۲۰

## فصل سوم: روشهای اتصال سیستم فتوولتائیک به شبکه و ردیاب نقطه ماکزیمم توان

- ۱-۳ معرفی ..... ۲۳
- ۲-۳ روند تحولات اینورترهای فتوولتائیک ..... ۲۴
- ۱-۲-۳ فن آوری های گذشته ..... ۲۴
- ۲-۲-۳ فن آوری کنونی اینورترهای رشته ای و ماژول های AC ..... ۲۵
- ۳-۲-۳ آئینده اینورترهای چند رشته ای ، ماژول AC ، و سلول AC ..... ۲۶
- ۳-۳ بررسی اینورترهای فتوولتائیک تک فاز متصل به شبکه ..... ۲۷
- ۴-۳ دسته بندی توپولوژی اینورترها ..... ۲۷
- ۱-۴-۳ تعداد مراحل پردازش قدرت ..... ۲۷
- ۲-۴-۳ جداکننده های قدرت ..... ۲۸
- ۳-۴-۳ ترانسفورماتور و انواع ارتباطات ..... ۲۹
- ۵-۳ مقایسه انواع اینورترهای فتوولتائیک ..... ۲۹
- ۶-۳ استانداردها، مشخصات و تقاضاهای اینورترهای فتوولتائیک ..... ۳۲
- ۷-۳ بحث و نتیجه گیری اینورترهای فتوولتائیک ..... ۳۴
- ۸-۳ الگوریتم های ردیابی نقطه ماکزیمم توان ..... ۳۵
- ۱-۸-۳ الگوریتم اغتشاش و نظارت ..... ۳۸
- ۲-۸-۳ الگوریتم هدایت افزایشی ..... ۴۱

## فصل چهارم: طراحی شبیه سازی و ساخت اینورتر فلای بک پیشنهادی

- ۱-۴ معرفی ..... ۴۷



۴۷	..... ۲-۴ طراحی مبدل فلای بک
۴۸	..... ۱-۲-۴ حالت پیوسته جریان در مبدل فلای بک
۵۰	..... ۲-۲-۴ حالت ناپیوسته جریان در مبدل فلای بک
۵۲	..... ۳-۴ اینورتر فلای بک با ترانسفورماتور سر وسط
۵۲	..... ۱-۳-۴ ساختار اینورتر فلای بک با ترانسفورماتور سر وسط
۵۵	..... ۲-۳-۴ الگوریتم کنترل کلیدها در اینورتر فلای بک
۵۵	..... ۴-۴ محاسبات اینورتر فلای بک در دو حالت پیوسته و ناپیوسته
۵۶	..... ۱-۴-۴ محاسبه ضریب روشن بودن کلید (D)
۵۷	..... ۲-۴-۴ محاسبه ضریب توان
۶۱	..... ۵-۴ مراحل طراحی اینورتر فلای بک
۶۳	..... ۶-۴ طراحی ترانسفورماتور اینورتر فلای بک
۶۴	..... ۷-۴ انتخاب قطعات اینورتر فلای بک
۶۷	..... ۸-۴ الگوریتم ردیابی نقطه ماکزیمم توان (MPPT)
۶۸	..... ۹-۴ نتایج شبیه سازی
۷۰	..... ۱۰-۴ نتایج آزمایشگاهی
<b>فصل پنجم: نتایج</b>	
۷۶	..... ۱-۵ نتیجه گیری
۷۷	..... ۵-ملاحظات پایانی
۷۸	..... مراجع

## فهرست شکل ها

- شکل ۱-۲ نحوه تولید جریان در سلول فتوولتائیک ..... ۷
- شکل ۱-۲ مدل ساده سلول فتوولتائیک ..... ۱۰
- شکل ۲-۲ منحنی I-V یک سلول فتوولتائیک ..... ۱۲
- شکل ۲-۳ مدل کامل سلول فتوولتائیک ..... ۱۳
- شکل ۲-۴ اثر افزایش سلول های فتوولتائیک ..... ۱۴
- شکل ۲-۵ ماژول فتوولتائیک مدل As-M40 ساخت کارخانه آریا سولار ..... ۱۵
- شکل ۲-۶ مدل معمول ماژول فتوولتائیک ..... ۱۶
- شکل ۲-۷ اثر افزایش دما بر منحنی مشخصه I-V ماژول فتوولتائیک ..... ۱۷
- شکل ۲-۷ نقطه ماکزیمم توان بر روی منحنی مشخصه I-V ماژول فتوولتائیک ..... ۱۸
- شکل ۳-۱ انواع تکنولوژی اینورترهای سیستم های فتوولتائیک متصل به شبکه ..... ۲۵
- شکل ۳-۲ توپولوژی بر اساس دسته بندی تعداد مراحل پردازش قدرت ..... ۲۸
- شکل ۳-۳ محل های مختلف خازن جداکننده ..... ۲۸
- شکل ۳-۴ انواع اینورتر های فتوولتائیک ..... ۳۱
- شکل ۳-۵ مقاومت ورودی مبدل فتوولتائیک ..... ۳۶
- شکل ۳-۶ نقطه ماکزیمم توان در منحنی I-V در مقادیر مختلف تابش و درجه حرارت ۲۵.....۳۷
- شکل ۳-۷ نقطه ماکزیمم توان در منحنی I-V در مقادیر مختلف تابش و درجه حرارت ۵۰.....۳۷
- شکل ۳-۸ ردیابی نقطه ماکزیمم توان ..... ۳۹
- شکل ۳-۹ فلوجارت الگوریتم اغتشاش و نظارت ..... ۳۹

- شکل ۱۰-۳ عیب الگوریتم اغتشاش و نظارت در سیستم فتوولتائیک ..... ۴۱
- شکل ۸-۳ فلوجارت الگوریتم هدایت افزایشی ..... ۴۴
- شکل ۱-۴ ساختارمداری مبدل فلای بک ..... ۴۹
- شکل ۲-۴ موج های الف - جریان خروجی ب- جریان خازن ج- جریان ورودی د- ولتاژ سلف ..... ۴۹
- شکل ۳-۴ وضعیت (۱) و (۲) برای یک مبدل فلای بک ..... ۵۰
- شکل ۴-۴ الف- ولتاژ سلف ترانسفورماتور ب- جریان سلف ترانسفورماتور ..... ۵۲
- شکل ۵-۴ ساختارمداری اینورتر فلای بک سیستم فتوولتائیک ..... ۵۳
- شکل ۶-۴ نحوه پالس دهی به گیت IGBT ها ..... ۵۴
- شکل ۷-۴ عملکرد اینورتر درحالت های مختلف ..... ۵۴
- شکل ۴-۸ نحوه تولید سیگنال گیت IGBT ها ..... ۵۵
- شکل ۴-۹ مدار معادل اینورتر فلای بک از دید شبکه ..... ۵۹
- شکل ۱۰-۴ شکل موج جریان در اولیه ترانسفورماتور در دو حالت CCM و DCM ..... ۵۹
- شکل ۴-۱۱ مدار ساخت موج مثلثی با اپ امپ ۱۴۵۸ ..... ۶۵
- شکل ۴-۱۲ مدار راه اندازی IGBT2 و IGBT3 توسط توتم پل و اپتو کوپلر ..... ۶۷
- شکل ۴-۱۳ نتایج ردیابی نقطه ماکزیمم توان به روش اغتشاش و نظارت ..... ۶۸
- شکل ۴-۱۴ ساختار کلی کنترل سیستم فتوولتائیک ..... ۶۹
- شکل ۴-۱۵ منحنی جریان تزریق شده به شبکه همراه با ولتاژ آن در سیستم فتوولتائیک ..... ۶۹
- شکل ۴-۱۶ جریان IGBT1 شبیه سازی شده ..... ۷۰
- شکل ۴-۱۷ شبیه سازی مبدل فتوولتائیک با ایده مطرح شده ..... ۷۰

- شکل ۴-۱۸ مبدل فتوولتائیک ساخته شده..... ۷۱
- شکل ۴-۱۹ PCB مبدل فتوولتائیک ساخته شده ..... ۷۲
- شکل ۴-۲۰ PCB مبدل فتوولتائیک طراحی شده در نرم افزار پرتئوس..... ۷۲
- شکل ۴-۲۱ جریان تزریق شده به شبکه..... ۷۳
- شکل ۴-۲۲ ولتاژ شبکه..... ۷۳
- شکل ۴-۲۳ جریان کلید اصلی..... ۷۴

#### فهرست جداول

- جدول ۲-۱ مشخصات ماژول فتوولتائیک مدل As-M40 در تابش  $1000 \text{ W/m}^2$  و دمای  $25^\circ\text{C}$ ..... ۱۵
- جدول ۳-۱ خلاصه ای از مشخصات اینورترهای ماژول AC..... ۳۰
- جدول ۳-۲ خلاصه ای از مقایسه اینورترهای ماژول AC..... ۳۰
- جدول ۳-۳ خلاصه ای از استانداردهای سیستم های فتوولتائیک..... ۳۳
- جدول ۴-۱ مشخصات اینورتر فلای بک فتوولتائیک ..... ۶۳

# فصل اول: بیان مسئله

## ۱-۱ مقدمه

گسترش روز افزون الکترونیک قدرت موجب شده تا مبدل‌های گوناگونی به وجود آیند. این روند توسعه عناصر نیمه هادی را از نظر کیفیت و به‌کارگیری آن‌ها در مبدل‌های توان به ابزارهای سودمندی برای تبدیل منابع مختلف الکتریکی که بتوانند مشخصات مورد نیاز بارهای گوناگون را برآورند تبدیل نموده است.

انرژی خورشید ، مؤثرترین منبع انرژی تجدید پذیر برای تولید برق با استفاده از سلول فتوولتائیک است. بدیهی است بهینه سازی سیستم تبدیل توان ، به اندازه یک ماژول فتوولتائیک در انتقال توان بسیار موثر است و باید موجب حداکثر انتقال توان از نور خورشید به باتری‌ها و یا شبکه شود. ولتاژ یک سلول فتوولتائیک کم است، بنابراین ، برای دریافت ولتاژ مناسب باید سلول‌ها را به صورت مجموعه ای سری به یکدیگر اتصال داد.

## ۱-۲ ضرورت توسعه سیستم‌های فتوولتائیک

موضوع انرژی از مسائل بسیار مهم در جهت پیشرفت‌های همه جانبه بشری است. خورشید به عنوان یک منبع بی پایان انرژی می‌تواند حلال مشکلات موجود در مورد انرژی و محیط زیست باشد. اما از نور خورشید به طور مستقیم نمی‌توان به خوبی بهره برد بلکه باید دستگاه‌هایی ساخته شود که بتوانند انرژی تابشی خورشید را به انرژی قابل استفاده نظیر انرژی الکتریسیته تبدیل کنند. استفاده از سیستم فتوولتائیک به چندین دلیل مفید است. چرا که تبدیل نور خورشید به الکتریسیته مستقیم است و مانند سیستم‌های تولید کننده مکانیکی به فضای زیادی نیاز ندارند. خصوصیت ماژولی انرژی فتوولتائیک اجازه می‌دهد که به طور سریع آرایش‌ها در هر اندازه مورد نیاز نصب شوند.

همچنین تأثیرات سوء زیست محیطی یک سیستم فتوولتائیک بسیار کم است، برای این سیستم به آب نیاز نیست. سلول‌های فتوولتائیک، همانند باتری‌ها، جریان مستقیم تولید می‌کنند که به طور عمومی برای کاربردهای کوچک مانند ابزار الکترونیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما هنگامی که برای کاربردهای تجاری مورد استفاده قرار گیرد بسیار مفید است.

تزیق انرژی سیستم‌های فتوولتائیک به شبکه‌های الکتریکی باید به صورت جریان متناوب باشد که برای استفاده به مبدل‌هایی نیاز داریم که اینورتر نام دارد، اینورترها ابزارهایی هستند که جریان مستقیم را به جریان متناوب تبدیل می‌کنند. به طور سنتی سیستم‌های فتوولتائیک در مناطق دورافتاده برای تولید الکتریسیته بکار گرفته شده‌اند. با این وجود یک بازار مطمئن برای تولید انرژی الکتریکی می‌تواند اقتصاد و اعتبار سیستم قدرت را بهبود بخشد.

## ۱-۳ اهداف این پایان نامه

در پایان نامه حاضر اهداف زیر مدنظر است:

- ۱- بررسی مطالعاتی که در این زمینه تاکنون انجام شده است.
- ۲- پارامترهای مورد نیاز برای شبیه سازی استخراج گردیده است.
- ۳- طراحی و ساخت یک سیستم فتوولتائیک که بتواند انرژی خورشیدی را به انرژی الکتریکی تبدیل کرده و این انرژی به شبکه انتقال دهد.
- ۴- طراحی و ساخت اینورتری که با روش کنترلی جدید می تواند جریان مستقیم به مبدل جریان متناوب با استفاده از نمونه برداری از ولتاژ شبکه تبدیل کند.
- ۵- کاهش تعداد کلید های فرکانس سوئیچینگ بالا در مقایسه با بسیاری از مبدل های دیگر ارائه شده برای سیستم های فتوولتائیک.
- ۶- طراحی یک کنترل کننده که می تواند این سیستم فتوولتائیک را در عمل کنترل کرده و حداکثر توان آرایه فتوولتائیک ارائه دهد.
- ۷- بررسی ویژگی های آرایه فتوولتائیک.
- ۸- ردیابی نقطه حداکثر توان (MPPT)، و ارائه دو الگوریتم مختلف برای آن.

## ۴-۱-۴ محتوی این پایان نامه

در این تحقیق ابتدا به بررسی ویژگی های ماژول فتوولتائیک می پردازیم بعد از آن ساده ترین و مدل دقیق تر سلول فتوولتائیک را بیان می کنیم. در ادامه مدل سازی ماژول فتوولتائیک در نرم افزار Matlab را ارائه می دهیم.

سپس به منحنی مشخصه ولتاژ جریان ماژول فتوولتائیک و ویژگی‌های آن می‌پردازیم. بعد از آن به اصول کار مبدل فلای بک را یاد آور می‌شویم. در فصل سوم مروری بر اینورترهای فتوولتائیک متصل به شبکه خواهیم داشت. در ادامه این فصل الگوریتم‌های مختلف ردیابی نقطه ماکزیمم توان را بیان می‌کنیم.

فصل چهارم را با بیان محاسبات تئوری مبدل فلای بک آغاز می‌کنیم، بعد از آن محاسبات و طراحی اینورتر فلای بک را بیان می‌کنیم در ادامه این فصل به شبیه سازی‌های اینورتر و ردیاب نقطه ماکزیمم توان می‌پردازیم و در انتها به نحوه اجرای مبدل فتوولتائیک و ارائه نتایج آزمایشگاهی آن می‌پردازیم.

در فصل پنجم نیز نتایج و پیشنهادات را بیان می‌کنیم



## فصل دوم: مبانی نظری پدیده فتوولتائیک و اجزای سیستم مذکور

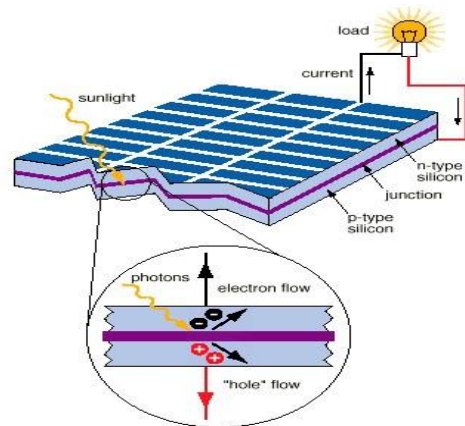
## ۲-۱ پدیده فتوولتائیک

به پدیده ای که در اثر تابش نور بدون استفاده از سیستم‌های متحرک ، الکتریسیته تولید می‌کند، پدیده فتوولتائیک و به هر سیستمی که از این پدیده استفاده کند سیستم فتوولتائیک می‌گوییم.

قدمت فتوولتائیک به سال ۱۸۳۹ وقتی که فیزیکدان فرانسوی، ادmond بکرل، اولین اثر فتوولتائیک را کشف کرد و آن زمانی بود که او به روشن کردن یک الکتروود فلزی به وسیله حلال الکترولیتی پرداخت. ۳۷ سال بعد، فیزیکدان بریتانیایی، ویلیام آدامز، با دانشجوی خود ریچارد رز، مواد فتوولتائیکی کشف کرد که از ، سیلیسیم، ساخته شده و سلول‌های جامدی با بازده ۲٪ ~ ۱ بود و به طور گسترده ای در دوربین‌های اندازه گیری بکار می‌رفت. [۲]

در سال ۱۹۵۴ اولین نسل از سلول‌های فتوولتائیک مبتنی بر نیمه هادی سیلیسیم ، با راندمان ۶ درصد در برنامه های فضایی به اجرا درآمد. تولید سلول‌های فتوولتائیک با منحنی رشد نمایی با پیشرفت تکنولوژی از اواخر دهه ۸۰ میلادی آغاز شد است که به سرعت در حال بهبود راندمان و کاهش هزینه است. [۲]

سیستم های فتوولتائیک یکی از پرمصرفترین کاربرد انرژی تجدید پذیر می‌باشند و تاکنون سیستم‌های گوناگونی با ظرفیت‌های مختلف در سراسر جهان نصب و راه اندازی شده‌اند. امروزه این گونه سلول‌ها عموماً از ماده سیلیسیم تهیه می‌شود و سیلیسیم مورد نیاز از شن و ماسه تهیه می‌شود که در مناطق کویری به فراوانی یافت می‌شود. [۸]



شکل ۲-۱ نحوه تولید جریان در سلول فتوولتائیک [۲]

## ۲-۲ سلول فتوولتائیک

یک سلول خورشیدی وسیله‌ایست که از نیمه هادی نوع  $n$  و  $p$  با اتصال الکتریکی تشکیل شده و انرژی پرتوهای خورشید که همان فوتون هستند را جذب کرده و به طور مستقیم به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند.

فوتون‌های نور با انرژی بیشتر از انرژی باند در مواد فتوولتائیک می‌توانند الکترون‌ها را از اتم‌ها جدا کنند و یک حفره به وجود آورند که این موضوع در شکل ۲-۱ نشان داده شده است. با این حال، الکترون دیگری به زودی دوباره به حفره سقوط می‌کند. الکترون‌هایی که در باند هدایت قرار دارند می‌توانند به طور مداوم به دور از حفره‌ها به سمت تماس با الکتروود فلزی حرکت کنند و یک جریان الکتریکی به وجود آورند. و یا به بیان بهتر جذب پرتوهای نوری موجب شکستن پیوند کووالانسی که نماینده بهم پیوستگی شیمیایی اتم‌ها در نیمه هادی (سلسیم) است، می‌گردد. در این فرآیند دو نوع بارهای متحرک در یک شبکه نیمه هادی با الکترون‌های منفی آزاد و حفره‌های مثبت آزاد، تولید می‌شوند. در نتیجه، بارهای منفی به یک طرف و بارهای مثبت به طرف دیگر روانه می‌گردند. در اثر جدا شدن بارها، پتانسیل الکتریکی  $V$  در بین دو سر نیمه هادی ایجاد می‌شود. با گذاشتن الکترودهایی در دو طرف نیمه هادی، جریان الکتریکی  $I$  را می‌توان توسط یک بار خارجی برقرار نمود [۸].

سلول‌های خورشیدی را باید از فتوسل‌ها که با استفاده از خواص رسانائی نوری مواد، میزان شدت نور را اندازه‌گیری می‌کنند، متمایز نمود. فتوسل‌ها نسبت به نور بسیار حساس بوده و رسانائی آن‌ها در نتیجه تغییر بسیار جزئی شدت نور، چندین برابر تغییر می‌کند.

اولین وسیله و کوچک‌ترین واحد مستقل تمامی سیستم‌های فتوولتائیک، سلول خورشیدی می‌باشد. اندازه آن می‌تواند با توجه به کاربرد مورد نظر به نحو مطلوب انتخاب گردد. اندازه سلول از چندین میلی‌متر مربع برای کاربردهای الکترونیکی از قبیل ماشین‌ها حساب جیبی، ساعت مچی و غیره تا اندازه استاندارد فعلی  $10 \times 10$  سانتی متر مربع تغییر می‌کند.

شکل سلول مربع مستطیل می‌باشد، ولی شکل‌های دیگری همچون دایره، نیم دایره و یا سایر اشکال که دارای هزینه ساخت کمتری را در بر داشته باشند، نیز تولید شده است. نکته مهم اینست که سلول‌های خورشیدی را می‌توان در شکل‌های فیزیکی متفاوت ساخته و تولید نمود ولی به خاطر اینکه بسیار نازک هستند، خاصیت شکنندگی پیدا کرده و در نتیجه از نظر اندازه دارای محدودیت می‌باشند. [۸]

سلول‌های خورشیدی از زمره دستگاه‌های بسیار نازک می‌باشند. به طور مثال ضخامت سلول  $0.3$  میلی متر یعنی حدود ضخامت چند صفحه کاغذ معمولی می‌باشد. در حال حاضر تحقیق و توسعه برای هرچه نازک‌تر ساختن سلول‌های خورشیدی به منظور به حداقل رساندن مصرف مواد نیمه هادی و در نتیجه هزینه ساخت آن‌ها، در مراکز تحقیقاتی دنیا در جریان است.

یک سلول خورشیدی از یک لایه بسیار نازک (حدود چند میکرون) از سیلیسیم نوع  $n$  و لایه ضخیم‌تری از سیلیکون نوع  $p$  تشکیل یافته است. اغلب سلول‌های خورشیدی از تک بلور سیلیکون ساخته می‌شوند، ولی از نیمه هادی‌های دیگر از جمله سیلیسیم آمورف، سیلیسیم چند بلوره، آرسنید گالیوم، سولفید کادمیوم و ترکیبات دیگر که از سیلیسیم تک بلور ارزان‌تر می‌باشد، نیز در ساخت سلول‌های خورشیدی استفاده می‌گردد. که هرچقدر میزان خلوص سیلیسیم در سلول بیشتر باشد، راندمان آن هم افزایش می‌یابد. یک سلول خورشیدی با اندازه  $10$  سانتی متر در  $10$  سانتی متر چنانچه مستقیماً در معرض تابش مستقیم خورشید قرار گیرد، توانی نزدیک به  $1/5$  وات تولید می‌نماید. اگرچه سیلیسیم عنصر فراوانی است و درصد زیادی از پوسته زمین را تشکیل می‌دهد، ولی سلول‌های فتوولتائیک قیمت بالایی دارند و این به خاطر فرآیند ساخت و خالص سازی سیلیسیم می‌باشد [۸].

یکی از معیارهای مهم توسعه و ساخت یک سلول خورشیدی به حداکثر رساندن راندمان تبدیل نور خورشید به الکتریسیته می‌باشد. در سلول‌های خورشیدی مکانیزم‌های مختلف افت انرژی وجود دارد که بعضی از آن‌ها غیر قابل اجتناب بوده و ذاتاً در سلول وجود دارند ولی برخی دیگر قابل کنترل می‌باشند و می‌توان آن‌ها را به حداقل رسانید و به کلی حذف کرد. با توجه به این امر راندمان ایده‌آل یک سلول در حدود  $30$  درصد می‌باشد. راندمان سلول‌های خورشیدی تجاری تحت تابش مستقیم خورشید، در حدود  $12$  الی  $17$  درصد می‌باشد، ولی در سطح آزمایشگاهی به راندمان‌های بالاتری نیز دست یافته‌اند. مثلاً راندمان سلول‌های خورشیدی منفرد از نوع کریستال‌های سیلیکون به  $23$  درصد و راندمان سلول‌هایی که پرتوهای خورشیدی بر روی آنها متمرکز می‌شوند تا  $32$  درصد گزارش شده است.

به منظور افزایش بازدهی سلول‌های خورشیدی که در سطوح مسطح قرار می‌گیرند، از یک روش، تعبیه سیستم‌های موثر متمرکز کننده استفاده می‌شود. متمرکز سازی پرتوهای خورشیدی، چگالی توان نور خورشید بر روی سلول‌ها را افزایش داده و بنابراین سطح مورد نیاز سلول‌های خورشیدی را برای تولید توان خروجی کاهش می‌دهد. جهت بررسی سیستم فتوولتائیک لزوم داشتن مدل فیزیکی و به دنبال آن مدل ریاضی می‌باشیم تا تجزیه و تحلیل سیستم مقذور گردد [۱۶].